

2005年7月14日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 梅野 正隆

独立行政法人 日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会 第103回研究会開催通知
テーマ：「シリコン基板結晶の評価技術」

1. 日時：2005年7月21日(木)午前10時より午後6時まで

2. 会場：弘済会館 4階会議室さくらの間

3. 内容：

10:00-10:10 開会あいさつ 大阪府立大学 井上 直久

1. 10:10-10:55 「第一原理計算による点欠陥と不純物の相互作用解析」
岡山県立大 末岡 浩治

2. 10:55-11:25 「Introductory talk」 筑波大学 山部 紀久夫

3. 11:25-12:10 「フラッシュメモリにおけるゲッタリング技術の重要性」
Spansion Japan 平野 頼

昼食

4. 13:30-14:15 「欠陥評価法の標準化の経過と課題」 東芝セラミクス 竹田 隆二

5. 14:15-15:00 「ドライエッチングによるBMD, DZの評価」 豊田中研 中嶋 健次
休憩

6. 15:20-16:05 「光散乱トモグラフィ法の散乱強度解析とその応用」
産総研(九州センター) 坂井一文

7. 16:05-16:50 「レーザ散乱法による結晶欠陥の高感度・非破壊計測」
三井金属鉱業 守矢 一男

8. 16:50-17:35 「赤外レーザ照射によるシリコン中不純物の拡散増速と酸素析出抑制」
富士通研究所 金田 寛

9. 17:35-17:55 「窒素濃度測定法の進展」 大阪府立大学 井上直久

18:00-19:30 懇親会 (会費：2,000円を予定)

担当幹事 大阪府立大学 井上 直久

会場

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1、TEL: 03-5276-0333

JR 四ツ谷駅下車 徒歩5分

地下鉄丸の内線四ツ谷駅下車徒歩5分、または地下鉄有楽町線麹町駅下車徒歩2分